

Efficient Power Conversion (EPC)、高電力密度の通信、ネットコム、コンピューティングのソリューションに最適な定格 40 V の eGaN FET を発売

EPCは、耐圧40 V、オン抵抗1.3 mΩのeGaN[®] FETである[EPC2067](#)を発売し、高性能でスペースに制約のあるアプリケーション向けに、MOSFETよりも小型、高効率で、信頼性の高いデバイスを提供します。

エンハンスメント・モードの窒化ガリウム・オン・シリコン (eGaN) のパワーFETとICの世界的リーダーである EPC (Efficient Power Conversion Corporation、本社：カリフォルニア州エルセグンド) は 10 月 27 日、eGaN FET の「[EPC2067](#)」(標準 1.3 mΩ、40 V) を発売し、低電圧の既製の窒化ガリウム・トランジスタの選択肢を拡大したと発表しました。

EPC2067 は、48 V～54 V 入力のサーバーなど、高電力密度化に対する厳しい要件があるアプリケーションに最適です。より小さいゲート電荷と逆回復損失ゼロによって、最先端の電力密度が得られ、面積がわずか 9.3 mm²、高効率で 1 MHz 以上の高周波動作が可能です。

「EPC2067 は、LLC DC-DC コンバータの 2 次側向けに、40 V～60 V 入力、12 V 出力の理想的なスイッチになります。この 40 V のデバイスは、前世代の 40 V の GaN FET と比べて性能とコストが改善されているので、経済的に、効率と電力密度を向上できます」と共同創業者で CEO (最高経営責任者) の Alex Lidow (アレックス・リドウ) は述べています。

開発基板

開発基板の [EPC90138](#) は、最大デバイス電圧 40 V、最大出力電流 40 A で、ゲート駆動回路を備えたハーフブリッジで、eGaN FET の [EPC2067](#) を搭載しています。この 2 インチ×2 インチ (50.8 mm×50.8 mm) の基板は、最適なスイッチング特性を実現するために設計されており、EPC2067 を簡単に評価するためのすべての重要な部品が搭載されています。

EPC について

EPC は、エンハンスメント・モード窒化ガリウム (eGaN[®]) に基づいたパワー・マネジメント (電源管理) ・デバイスのリーダーです。eGaN FET と集積回路は、[DC-DC コンバータ](#)、[リモート・センシング技術 \(Lidar\)](#)、イーモビリティ向け[モーター駆動](#)、ロボット、ドローン、[低価格衛星](#)などの用途で、最高のパワーMOSFETよりも何倍も高性能です。日本語ウェブサイトは www.epc-co.com/epc/jp/ です。

eGaN は、Efficient Power Conversion Corporation, Inc.の登録商標です

報道関係の問い合わせ先

Efficient Power Conversion : Winnie Wong (winnie.wong@epc-co.com)